

Тематический указатель статей, опубликованных в 2005 году

МИЭТ – 40 лет

Бархоткин В.А., Рыгалин Б.Н., Пустовит В.Ю. Научные исследования в МИЭТ. № 4–5, с. 15.
Беспалов В.А. Инновационная структура МИЭТ. № 4–5, с. 22.
Поспелов А.С., Акуленок М.В., Леонтьев В.Б. Развитие системы подготовки специалистов в МИЭТ (2001–2005). № 4–5, с. 11.
Чаплыгин Ю.А. МИЭТ – 40. № 4–5, с. 6.

Фундаментальные исследования

Горбачевич А.А., Егоркин В.И., Канаев В.В., Конаев Ю.В., Мороча А.К., Шмелев С.С. Полупроводниковые гетероструктуры и квантовые приборы на их основе. № 4–5, с. 31.
Горбачевич А.А., Жабицкий О.В. Микроскопическая теория симметричных гетеропереходов. № 2, с. 3.
Плис В.И., Попов А.И. Перестройка спиновой структуры и намагничивание высокомолекулярных магнитных кластеров в сильных магнитных полях. № 4–5, с. 39.
Поспелов А.С. О применении операторов усреднения в задаче сжатия дискретных сигналов. № 2, с. 11.

Материалы электронной техники

Апрелов С.А., Гайдуков Г.Н., Герасименко Н.Н., Медетов Н.А. Фрактальный анализ упорядоченности поверхностных микроструктур. № 2, с. 25.
Арендаренко А.А., Голодаева Н.Л., Литвинов Ю.М., Цыпленков И.Н., Хуснетдинов И.А., Бардушкин В.В. Эффективные упругие характеристики пространственно неоднородных материалов. № 2, с. 19.
Бардушкин В.В., Яковлев В.Б., Булах И.И., Серов М.М. Неоднородность упругих свойств поликристаллических лент алюминия. № 6, с. 21.
Батюня Л.П. Управление свойствами оксидных многокомпонентных материалов с использованием модифицирующих элементов. № 6, с. 28.
Боргардт Н.И., Зыков А.В., Кукин В.Н., Максимов С.К. Электронно-микроскопические методы исследования наноструктурированных и нанофазных материалов. № 4–5, с. 44.
Неустроев С.А., Неустроев А.С. Перестановочная энтропия плотнейших упаковок. № 3, с. 3.
Павлов В.Ф. Глубина и структура повреждений в пластинах GaP, полученных методом многопроволочной резки. № 2 с. 32.
Соколов Е.Б., Рыгалин Б.Н., Смирнов В.В., Прокофьева В.К., Найда Г.А. Кремний и широкозонные нитриды – основа полупроводниковой энергетики. № 4–5, с. 52.
Соловей В.В., Литвинов Ю.М. Диагностика субмикронных приповерхностных повреждений в пластинах кремния после двухстороннего химико-механического полирования. № 6, с. 32.
Шерченков А.А. Гетероструктуры на основе некристаллических полупроводников для приборного применения. № 4–5, с. 58.

Технология микроэлектроники

Бархоткин В.А., Райнова Ю.П., Терентьев А.И., Райнов А.Ю. Алгоритм управления температурным режимом в быстрых термических процессах. № 6, с. 46.

Грушевский А.М., Семенин С.Н., Жуков П.А., Карвасарный В.В. Технология прецизионного монтажа на полиимидных платах. № 6, с. 36.

Крупкина Т.Ю. Структура и основные элементы системы виртуального производства. № 6, с. 52.

Найда Г.А., Смирнов В.В. Технологические закономерности выращивания структур AlN и GaN на сапфире при использовании неорганических донорно-акцепторных комплексов. № 3, с. 7.

Сенокосов Э.А., Макаревич А.Л., Сорочан В.В. Исследование механизма переключения в слоях $n\text{CdTe:In}$. № 6, с. 41.

Смирнов В.В. Влияние разориентации R -плоскости сапфира на процесс гетероэпитаксиального осаждения нитридов алюминия и галлия. № 1, с. 5.

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы

Агеев О.А. Термодинамический анализ твердофазных взаимодействий в контактах Ni/SiC. № 2, с. 42.

Алексеев Ю.И., Демьяненко А.В. Расчет импеданса лавинно-пролетного диода в малосигнальном режиме. № 1, с. 25.

Бобрешов А.М., Хребтов И.В. Аналитическая модель для субмикронных HEMT-транзисторов с учетом короткоканальных эффектов. № 3, с. 14.

Булатов А.Н., Неволин В.К. Полевой эффект в квазиодномерном канале на танталовых пленках. № 2, с. 37.

Горбацевич А.А., Налбандов Б.Г., Старосельский В.И., Шмелев С.С. Арсенид-галлиевые интегральные микросхемы для систем телекоммуникаций, радиолокации и измерительной техники. № 4–5, с. 72.

Григорашвили Ю.Е., Ичкитидзе Л.П., Волик Н.Н., Бухлин А.В., Мингазин В.Т., Полякова Е.В. Исследование магниторезистивного эффекта в пленках высокотемпературного сверхпроводникового материала системы Bi–Pb–Sr–Ca–Cu–O. № 4–5, с. 87.

Киргизова А.В., Яненко А.В., Никифоров А.Ю., Григорьев Н.Г. Методика и результаты экспериментальных исследований сбоеустойчивости КМОП КНС оперативных запоминающих устройств при импульсном ионизирующем воздействии. № 3, с. 29.

Коркишко Ю.Н., Федоров В.А., Кострицкий С.М. Оптические волноводы и интегрально оптические устройства на кристаллах ниобата лития. № 4–5, с. 79.

Королев М.А., Крупкина Т.Ю., Чаплыгин Ю.А. Приборно-технологическое моделирование при разработке изделий микроэлектроники и микросистемной техники. № 4–5, с. 64.

Лугин А.Н., Оземша М.М. Воздействие давления окружающей среды на электрическое сопротивление тонкопленочных прецизионных резисторов. № 1, с. 19.

Минаев В.В., Уздовский В.В., Сондаевский Р.В., Уздовский Вл.В. Исследование спектральных характеристик фотоприемников с барьером Шотки на основе $p\text{-Si-Au}$. № 1, с. 12.

Севастьянов В.П., Кузьмин Н.Г. Методы повышения надежности жидкокристаллических индикаторов. № 1, с. 29.

Сергеев В.А. Аналитическая модель неизотермического распределения плотности мощности в структурах биполярных транзисторов. № 3, с. 22.

Чаплыгин Ю.А., Галушков А.И., Семёнов А.А., Усанов Д.А. Магнитоуправляемый динистор. № 6, с. 56.

Нанотехнология

Гаврилов С.А., Белов А.Н., Железнякова А.В., Вишник Е.В., Кравченко Д.А. Электрохимические процессы формирования твердотельных наноструктур. № 4–5, с. 94.

Булатов А.Н., Неволин В.К., Чаплыгин Ю.А. Зондовая технология в нанoeлектронике на основе углеродных элементов. № 4–5, с. 98.

Бархударов А.В., Гаврилов С.А., Голишников А.А., Путря М.Г. Получение наноразмерных матричных структур в кремнии. № 4–5, с. 102.

Герасименко Н.Н. Самоорганизованные имплантированные наноразмерные структуры в полупроводниках. № 4–5, с. 107.

Схемотехника и проектирование

- Анисимов В.А., Борисов А.Г., Волкова Г.В., Козлитин И.А., Крутоверцев С.А.* Математическое моделирование распространения света в изогнутых цилиндрических волноводах. № 1, с. 35.
- Артемов С.А.* Разработка конвертора проекта интегральных схем из базиса ПЛИС в базис БМК. № 1, с. 42.
- Дубровин С.А.* Объектные представления в базах данных САПР СБИС. № 3, с. 56.
- Казённов Г.Г.* Интеграция процессов проектирования интегральных схем и систем. № 4–5, с. 130.
- Казённов Г.Г., Миргородский А.Ю.* Метод оценки коэффициента масштабирования с применением интегральных характеристик бинаризованного изображения. № 3, с. 51.
- Ковалев А.В.* Метод проектирования систем–на–кристалле на основе сетевых алгоритмов. № 2, с. 49.
- Лаврентьев М.В., Круглов Ю.В.* Выбор архитектуры многокаскадного сигма-дельта модулятора на основе оценки «просачивающегося» шума квантования и физического шума. № 3, с. 40.
- Семенов М.Ю., Калашиников В.С., Ласточкин О.В.* Применение аппарата модулярной арифметики для построения фильтра с конечной импульсной характеристикой. № 3, с. 46.
- Соловьев Р.А., Глебов А.Л., Гаврилов С.В.* Анализ помех, влияющих на задержку прохождения сигнала в цифровых СБИС, на основе логических ограничений. № 6, с. 61.
- Тафинцев К.С.* Модель для анализа алгоритмов коррекции ЦАП обратной связи в многоразрядных сигма-дельта модуляторах. № 3, с. 33.
- Щемелин В.М., Хамидулин Р.Х.* Методологические аспекты автоматизированного синтеза топологии СБИС. № 4–5, с. 137.
- Энкович А.В.* Проектирование малошумящих фильтров высокого порядка для сигма-дельта ЦАП. № 2, с. 54.

Микросистемы

- Амеличев В.В., Годовицын И.В., Красюков А.Ю., Поломоинов С.А., Чаплыгин Ю.А.* Оптимизация конструкции мембраны в теплодисперсионном датчике взрывоопасных газов. № 3, с. 60.
- Белов А.Н., Роцин В.М., Шевяков В.И.* Элементы микро- и наносистем в сканирующей зондовой микроскопии. № 4–5, с. 120.
- Вернер В.Д., Галушков А.И., Сауров А.Н., Шелепин Н.А.* Роль микросистемной техники в развитии инновационного потенциала НПК «Технологический центр». № 4–5, с. 113.
- Макарецкий Е.А., Овчинников А.В., Минаков Е.И.* Оптоэлектронный дистанционный измеритель давления. № 3, с. 68.
- Тимошенков С.П., Зотов С.А., Калугин В.В.* Разработка и изготовление чувствительных элементов микроэлектромеханических систем. № 4–5, с. 125.

Микропроцессорная техника

- Бурдинский И.Н.* Микропроцессорное устройство коррекции состава рабочей смеси для двигателя внутреннего сгорания. № 2, с. 66.
- Бурдинский И.Н., Миронов А.С.* Применение технологии «конфигурируемые системы на кристалле» для исследования рабочих режимов автомобильных двигателей внутреннего сгорания. № 6, с. 79.
- Кочетков В.Ю., Переверзев А.Л., Савченко Ю.В.* Первичная обработка управляющих сигналов с времяимпульсной модуляцией в условиях наличия комбинированной помехи. № 6, с. 75.
- Лыгач В.В., Грушевский А.М.* Применение программируемых микроконтроллеров в системах дистанционного управления с распределенной структурой. № 3, с. 74.
- Шагури И.И., Мокрецов М.О., Зварич Б.В., Лат М.М., Антонов А.М.* Применение коммуникационных контроллеров в распределенных системах автоматического управления. № 2, с. 58.
- Широ Г.Э., Романов С.П.* Алгоритм синтеза радиолокационных изображений для малых углов переднебокового обзора. № 6, с. 69.

Информационные технологии

Абрамов А.Ю., Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Концепция реализации учета электроэнергии в составе многофункциональной информационно-управляющей системы для распределительных электросетей. № 4–5, с. 168.

Баринев В.В., Кузнецов В.С., Тепляков И.М. Подвижные и сенсорные сети передачи данных. № 4–5, с. 157.

Бархоткин В.А., Кочетков М.П. Метод автоматического анализа изображений для бортовых вычислительных систем мобильных роботизированных комплексов. № 4–5, с. 143.

Игнатова И.Г. Инфраструктура для удаленного информационного взаимодействия в процессе подготовки и проведения научно-технической конференции. № 1, с. 62.

Корнеева М.В. Фрактальный анализ псевдослучайных последовательностей. № 1, с. 54.

Назаров Л.Е. Посимвольный прием частотно-манипулированных сигналов с непрерывной фазой, формируемых на основе двоичных блоковых кодов. № 1, с. 46.

Переверзев А.Л. Адаптивный цифровой фильтр на основе скользящего среднего. № 2, с. 70.

Умняшкин С.В., Коплович Д.М. Метод компрессии изображений на основе векторного квантования коэффициентов в области дискретных преобразований. № 4–5, с. 149.

Щагин А.В. Проектирование распределенных систем управления технологическими процессами непрерывных технологий. № 4–5, с. 161.

Приборостроение

Востриков В.А., Горбунов Б.Б., Гусев А.Н., Журип Д.В., Каменский С.А., Селищев С.В. Медико-технические принципы проектирования внешних электрических дефибрилляторов с биполярной формой импульса. № 4–5, с. 173.

Штерн Ю.И., Кожевников Я.С., Тарасов Р.Ю., Барабанов Д.Ю. Перспективы развития низкотемпературного термоэлектрического приборостроения. № 4–5, с. 179.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Чистюхин В.В. Особенности проектирования приемной АФАР с расширенным сектором сканирования. № 3, с. 80.

Методы и техника измерений

Чаплыгин Ю.А., Усанов Д.А., Скрипаль Ал.В., Скриаль Ан.В., Семёнов А.А., Абрамов А.В., Голишников А.А. Радиоволновые и оптические измерения толщины и электропроводности металлических пленок на полупроводниковых и диэлектрических подложках. № 1, с. 68.

Булярский С.В., Басаев А.С. Исследование рентгеночувствительных $p-i-n$ -структур методом термостимулированной спектроскопии глубоких уровней. № 1, с. 78.

Зиновьев Д.В. Аналитический метод оценки отношения сигнал/шум модулятора с передискретизацией. № 2, с. 73.

Дёмкин В.И., Макаров Е.С., Никулин В.Б. Алгоритм определения координат движущегося объекта. № 2, с. 77.

Булярский С.В., Басаев А.С., Суханов В.С. Температурные зависимости коэффициентов захвата глубоких центров в рентгеночувствительных приемниках излучения. № 6, с. 84.

Горлов М.И., Смирнов Д.Ю., Сегал Ю.Е., Емельянов А.В. Использование уровня шумов для контроля полупроводниковых изделий при термоциклировании. № 6, с. 89.

Биомедицинская электроника

Каменский С.А. Распределение амплитуд сигнала ЭКГ при шоковых и нешоковых ритмах сердца. № 2, с. 81.

Проблемы высшего образования

Акуленок М.В., Голубская И.Э. Исследование мотивационной сферы студентов. № 1, с. 83.

Краткие сообщения

Балашов А.Г. Исследование порогового напряжения вертикальной МОП-структуры с использованием методов приборно-технологического моделирования. № 3, с. 90.

Батюня Л.П. Метод синтеза особочистых многокомпонентных оксидных порошков. № 6, с. 99.

Герасименко Н.Н., Жуков А.А., Герасименко Н.Н. (мл.), Тарасенков А.Н., Ловягин И.В. Аномальное дефекто-образование в монокристаллическом кремнии при имплантации ионов фтора. № 4-5, с. 185.

Городилов А.В. Механизм динамического распределения ресурсов сервера между обработчиками запросов на основе прогнозирования нагрузки. № 3, с. 88.

Золотарев В.И., Нестеров Д.В., Черный Б.И. Индиевые микросферы для сборки ИС. № 1, с. 90.

Нестеров Д.В., Рудаков Г.А. Способ монтажа фоточувствительных приемников ИК-излучения. № 2, с. 90.

Никулин В.Б. Иноземцев Н.В. Сравнение статистического и интервального методов при решении задач градуировки средств измерения. № 6, с. 93.

Смирнов В.В. Моделирование процесса термообработки подложек сапфира в аммиаке при гетероэпитаксии широкозонных нитридов. № 2, с. 88.

Сопова О.В. Способ повышения устойчивости двухзатворного МОП-транзистора к короткоканальным эффектам. № 3, с. 92.

Спириин В.Г. Исследование конструктивной погрешности сопротивления тонкопленочного резистора. № 6, с. 97.

Тафинцев К.С. Увеличение динамического диапазона сигма-дельта АЦП методом тройной выборки внутреннего многозарядного ЦАП. № 6, с. 95.

Ушкар М.Н., Школьников В.М., Неудобнов Н.А. Структура стенда отладки CAN-узлов. № 1, с. 92.

Юбилей

Буцу Виктору Петровичу – 70 лет. № 2, с. 97.

Быкову Дмитрию Васильевичу – 60 лет. № 2, с. 95.

Валиеву Камиллю Ахметовичу – 75 лет. № 6, с. 99.

Грибову Борису Георгиевичу – 70 лет. № 2, с. 93.

Казённову Г.Г. – 70 лет. № 1, с. 95.

Памяти Якова Андреевича Федотова. № 1, с. 97.

22 Центральному научно-исследовательскому испытательному институту Министерства обороны Российской Федерации – 50 лет. № 6, с. 4.

Телец В.А., Негина Ю.С., Орлов А.А. Направления, базовые составляющие и условия развития микросистемной техники специального назначения. № 6, с. 9.

Конференции. Семинары. Выставки

2-я Международная конференция по физике электронных материалов. № 1, с. 34.

5-я Международная научно-практическая конференция «Электроника и информатика – 2005». № 1, с. 4 обложки.

8 февраля – День Российской Науки. Мизтовские научные чтения. №1, с. 98.

12-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2005». № 1, с. 4.

Вернер В.Д., Ковалев А.А., Резнев А.А., Сауров А.Н., Чаплыгин Ю.А. Быстрее, лучше, дешевле (выставка «Электроника - 2004» г. Мюнхен). № 3, с. 95.

Международная научно-практическая конференция «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». № 1, с. 67.

Об итогах 12-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2005». № 3, с. 94.

2-я Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании». № 6, с. 31.